

# Thyristor Modules

## Thyristor/Diode Modules

 $I_{TRMS} = 2x 180 A$   
 $I_{TAVM} = 2x 116 A$   
 $V_{RRM} = 800-1800 V$ 

$V_{RSM}$ $V_{DSM}$ V	$V_{RRM}$ $V_{DRM}$ V	Type	Version	1B	8B	Version	1B	8B
900	800	MCC 95-08	io1B / io8B	MCD 95-08	io1B / io8B			
1300	1200	MCC 95-12	io1B / io8B	MCD 95-12	io1B / io8B			
1500	1400	MCC 95-14	io1B / io8B	MCD 95-14	io1B / io8B			
1700	1600	MCC 95-16	io1B / io8B	MCD 95-16	io1B / io8B			
1900	1800	MCC 95-18	io1B / io8B	MCD 95-18	io1B / io8B			



Symbol	Conditions	Maximum Ratings
$I_{TRMS}, I_{FRMS}$ $I_{TAVM}, I_{FAVM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $T_C = 85^\circ C; 180^\circ$ sine	180 A 116 A
$I_{TSM}, I_{FSM}$	$T_{VJ} = 45^\circ C$ $V_R = 0$ $t = 10$ ms (50 Hz) $t = 8.3$ ms (60 Hz)	2250 A 2400 A
$I^2t$	$T_{VJ} = 45^\circ C$ $V_R = 0$ $t = 10$ ms (50 Hz) $t = 8.3$ ms (60 Hz)	25 300 A <sup>2</sup> s 23 900 A <sup>2</sup> s
$(di/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$ $f = 50$ Hz; $t_p = 200$ $\mu$ s; $V_D = 2/3 V_{DRM}$ $I_G = 0.45$ A $di_G/dt = 0.45$ A/ $\mu$ s	repetitive, $I_T = 250$ A 150 A/ $\mu$ s non repetitive, $I_T = I_{TAVM}$ 500 A/ $\mu$ s
$(dv/dt)_{cr}$	$T_{VJ} = T_{VJM}; V_D = 2/3 V_{DRM}$ $R_{GK} = \infty$ ; method 1 (linear voltage rise)	1000 V/ $\mu$ s
$P_{GM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}; t_p = 30$ $\mu$ s $I_T = I_{T(AV)M}; t_p = 500$ $\mu$ s	10 W 5 W
$P_{GAV}$		0.5 W
$V_{RGM}$		10 V
$T_{VJ}$		-40...+125 $^\circ C$
$T_{VJM}$		125 $^\circ C$
$T_{stg}$		-40...+125 $^\circ C$
$V_{ISOL}$	50/60 Hz, RMS $I_{ISOL} \leq 1$ mA	$t = 1$ min 3000 V~ $t = 1$ s 3600 V~
$M_d$	Mounting torque (M5) Terminal connection torque (M5)	2.5 - 4 Nm 2.5 - 4 Nm
Weight	Typical including screws	85 g

Data according to IEC 60747 and refer to a single diode unless otherwise stated.



### Features

- International standard package, JEDEC TO-240 AA
- Direct copper bonded  $Al_2O_3$  -ceramic base plate
- Planar passivated chips
- Isolation voltage 3600 V~
- UL registered, E 72873
- Gate-cathode twin pins for version 1

### Applications

- DC Motor control
- Softstart AC motor controller
- Light, heat and temperature control

### Advantages

- Space and weight savings
- Simple mounting with two screws
- Improved temperature & power cycling
- Reduced protection circuits

Symbol	Conditions	Characteristic Values	
		typ.	max.
$I_{RRM}, I_{DRM}$	$V_R / V_D = V_{RRM} / V_{DRM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	5 mA
$V_T, V_F$	$I_T / I_F = 300$ A	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	1.5 V
$V_{T0}$	For power-loss calculations only		0.8 V
$r_t$		$T_{VJ} = T_{VJM}$	2.4 mΩ
$V_{GT}$	$V_D = 6$ V	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	2.5 V 2.6 V
$I_{GT}$	$V_D = 6$ V	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	150 mA 200 mA
$V_{GD}$	$V_D = 2/3 V_{DRM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	0.2 V
$I_{GD}$			10 mA
$I_L$	$t_p = 10 \mu\text{s}; V_D = 6$ V $I_G = 0.45$ A; $di_G/dt = 0.45$ A/ $\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	450 mA
$I_H$	$V_D = 6$ V; $R_{GK} = \infty$ ;	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	200 mA
$t_{gd}$	$V_D = 1/2 V_{DRM}$ $I_G = 0.45$ A; $di_G/dt = 0.45$ A/ $\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	2 $\mu\text{s}$
$t_q$	$V_D = 2/3 V_{DRM}$ $dv/dt = 20$ V/ $\mu\text{s}$ ; $-di/dt = 10$ A/ $\mu\text{s}$ $I_T = 150$ A; $V_R = 100$ V; $t_p = 200 \mu\text{s}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	185 $\mu\text{s}$
$Q_S$	$I_T / I_F = 50$ A; $-di/dt = 6$ A/ $\mu\text{s}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	170 $\mu\text{C}$
$I_{RM}$			45 A
$R_{thJC}$	per thyristor; DC current per module	} other values see Fig. 8/9	0.22 K/W
$R_{thJK}$	per thyristor; DC current per module		0.11 K/W
			0.42 K/W
			0.21 K/W
$d_s$	Creeping distance on surface		12.7 mm
$d_A$	Creepage distance in air		9.6 mm
$a$	Maximum allowable acceleration		50 m/s <sup>2</sup>

Optional accessories for modules

Coded gate/cathode twin plugs with wire length = 350 mm, gate = yellow, cathode = red

Type **ZY 200L** (L = Left for pin pair 4/5) } UL 758, style 1385,  
 Type **ZY 200R** (R = Right for pin pair 6/7) } CSA class 5851, guide 460-1-1



Fig. 1 Gate trigger characteristics



Fig. 2 Gate trigger delay time





Fig. 3 Surge overload current  $I_{TSM}$ ,  
 $I_{FSM}$ : Crest value,  $t$ : duration



Fig. 4  $I^2t$  versus time (1-10 ms)



Fig. 4a Maximum forward current  
at case temperature



Fig. 5 Power dissipation versus  
on-state current & ambient  
temperature  
(per thyristor or diode)



Fig. 6 Three phase rectifier bridge:  
Power dissipation vs. direct  
output current and ambient  
temperature



Fig. 7 Three phase AC-controller:  
Power dissipation versus RMS  
output current and ambient  
temperature



Fig. 8 Transient thermal impedance  
junction to case  
(per thyristor or diode)

$R_{thJC}$  for various conduction angles d:

d	$R_{thJC}$ (K/W)
DC	0.22
180°	0.23
120°	0.25
60°	0.27
30°	0.28

Constants for  $Z_{thJC}$  calculation:

i	$R_{thi}$ (K/W)	$t_i$ (s)
1	0.0066	0.0019
2	0.0678	0.0477
3	0.1456	0.344



Fig. 9 Transient thermal impedance  
junction to heatsink  
(per thyristor or diode)

$R_{thJK}$  for various conduction angles d:

d	$R_{thJK}$ (K/W)
DC	0.42
180°	0.43
120°	0.45
60°	0.47
30°	0.48

Constants for  $Z_{thJK}$  calculation:

i	$R_{thi}$ (K/W)	$t_i$ (s)
1	0.0066	0.0019
2	0.0678	0.0477
3	0.1456	0.344
4	0.2	1.32

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9